

	<h2 style="color: red;">BSC010NE2LSIATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC010NE2LSIATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 38A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC010NE2LSIATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC010NE2LSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 38A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC010NE2LSI
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4200pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 38A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 96W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Ta), 100A (Tc)

BSC010NE2LSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC010NE2LSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC010NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC010NE2LSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC010NE2SXT INFINEON INFINEON TDFN-8-4</p>	 <p>BSC010NE2LS Infineon Technologies BSC010NE2LS Infineon Technologies</p>	 <p>BSC010NE2LSI Infineon Technologies BSC010NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC011N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>
 <p>BSC010NE2LSG infineon/ BSC010NE2LSG infineon/</p>	 <p>BSC010NE2LSATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDFS</p>	 <p>BSC010NE2LSICT-ND Infineo</p>	 <p>BSC011N03LS Infineon Technologies BSC011N03LS Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC010NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC010NE2LSIATMA1 Datenblatt	BSC010NE2LSIATMA1-Datenblätter	BSC010NE2LSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC010NE2LSIATMA1
BSC010NE2LSIATMA1 Electronic	BSC010NE2LSIATMA1-Komponenten	BSC010NE2LSIATMA1-Verteiler	BSC010NE2LSIATMA1-Bild	BSC010NE2LSIATMA1-Teil
BSC010NE2LSIATMA1 Preis	BSC010NE2LSIATMA1 Hersteller	BSC010NE2LSIATMA1 Bild	BSC010NE2LSIATMA1 Aktie	BSC010NE2LSIATMA1 Inventar
BSC010NE2LSIATMA1 Neu	BSC010NE2LSIATMA1 Original	BSC010NE2LSIATMA1 garantiert	BSC010NE2LSIATMA1 RFQ	BSC010NE2LSIATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited